Диэлектрическая релаксация жидкого кристалла транс-4-пропил (4-цианфенил) циклогексан

© Б.А. Беляев, Н.А. Дрокин, В.Ф. Шабанов

Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, 660036 Красноярск, Россия E-mail: belyaev@iph.krasn.ru

(Поступила в Редакцию 28 июля 2003 г.)

В нематической фазе жидкого кристалла транс-4-пропил (4-цианфенил) циклогексан измерены частотные зависимости диэлектрической проницаемости в диапазоне 1–2000 MHz при различной ориентации директора молекул относительно направления поляризации переменного электрического поля. Проведено сравнение температурных зависимостей диэлектрических и оптических характеристик в области фазового перехода нематик–изотропная жидкость. С помощью численной аппроксимации диэлектрических спектров получены времена дипольной релаксации для процессов вращения молекул вокруг коротких и длинных осей. Показано, что существенный вклад в релаксацию могут вносить внутримолекулярные движения. Определены значения активационной энтальпии.

Авторы выражают признательность Российскому фонду фундаментальных исследований за поддержку работы (грант № 03-03-32470).

Различие статических диэлектрических проницаемостей нематических жидких кристаллов (ЖК) при ориентации директора молекул вдоль направления электрического поля $\varepsilon_{\parallel 0}$ и ортогонально ему $\varepsilon_{\perp 0}$ обусловлено вращением молекул вдоль коротких и длинных осей [1]. Частотные зависимости продольной $\varepsilon_{\parallel}(f)$ и поперечной $\varepsilon_{\perp}(f)$ проницаемостей, как правило, хорошо описываются уравнениями Дебая с временами релаксации соответственно τ_{\parallel} и τ_{\perp} , которые могут различаться на несколько порядков. При этом время дебаевской релаксации для молекул многих ЖК в изотропном состоянии примерно совпадает с τ_{\perp} . Значительное смещение вниз по частоте области дисперсии $\varepsilon_{\parallel}(f)$ в нематической фазе объясняется наличием взаимодействия между молекулами ЖК, которое приводит к возникновению потенциального барьера, затрудняющего повороты молекул вокруг короткой оси [1,2].

Однако нередко диэлектрические спектры ЖК, измеренные в широкой области частот, имеют существенное отклонение от дебаевской аппроксимации, обусловленное проявлением дополнительных механизмов релаксации, вызванных, например, внутримолекулярными движениями. В частности, такого рода особенности диэлектрических спектров имеют ЖК из группы алкилцианобифенилов *n*-CB с n = 5-9, молекулы которых содержат жесткий ароматический остов и алкильный "хвост", состоящий из конформационно-подвижных метиленовых сегментов. В этих веществах наиболее сильное отклонение диэлектрической проницаемости от дебаевской зависимости обнаруживается в области высоких и сверхвысоких частот при ортогональной ориентации директора относительно направления поляризации поля накачки [3-6]. Наблюдаемое отклонение связано с индуцированной поляризуемостью алкильных цепей из-за изменения их конформационного равновесия в высокочастотных электрических полях. С ростом числа метиленовых групп в молекулах ЖК отклонение спектра $\varepsilon'_{\perp}(f)$ от дебаевской аппроксимации увеличивается, так как растет набор перекрывающихся областей собственных частот характерных конформационных движений и соответственно расширяется их частотный диапазон.

В работе [7] было показано, что в соединениях *n*-CB с $n \ge 5$ численная аппроксимация зависимости $\varepsilon'_{\perp}(f)$ может быть достаточно точно проведена с помощью дисперсионного уравнения Дебая, включающего асимметричную функцию непрерывного распределения времен релаксации в определенном интервале. Такой подход не позволяет разделить и идентифицировать вклады в релаксацию различных молекулярных движений, а также определить времена релаксации, связанные с движением ароматического остова и гибких концевых фрагментов молекул. При уменьшении числа алкильных групп до *n* = 3, например, в ЖК 5-пропил-2 (п-цианфенил)-пиридин диэлектрический спектр $\varepsilon'_{\perp}(f)$ хорошо аппроксимируется дисперсионным уравнением Дебая с использованием симметричной функции непрерывного распределения времен релаксации в относительно небольшом интервале (23.9–1.85) · 10⁻⁹ s [8]. При этом флуктуации изгиба цепей за счет внутренних поворотов сегментов в алкильном хвосте можно считать статистически независимыми [9], так как функции распределения их собственных частот почти не перекрываются.

Настоящая работа посвящена измерению и анализу диэлектрических спектров монотропного ЖК, транс-4-пропил (4-цианфенил) циклогексан (ЗРСН), обладающего небольшой длиной алкильного "хвоста" (n = 3). Структурная формула ЗРСН приведена на рис. 1. Монотропность этого ЖК состоит в том, что переход в жидкокристаллическую фазу в нем происходит при $t_c = 46^{\circ}$ С и только из изотропного состояния, получа-



Рис. 1. Структурная формула жидкого кристалла ЗРСН.

емого предварительным нагревом вещества до $t > t_c$. Температура кристаллизации ЗРСН $t \leq 36^{\circ}$ С и зависит от скорости охлаждения. Исследования проводятся с целью разделения вкладов в дисперсионные зависимости диэлектрических констант от различных вращательных (переориентационных) движений молекул и внутримолекулярных движений. Диэлектрические спектры регистрируются в диапазоне частот f = 1-200 МНz при нескольких фиксированных значениях угла φ между направлением директора молекул и направлением поляризации высокочастотного поля накачки. В области фазового перехода нематик–изотропная жидкость измеряются температурные зависимости диэлектрических констант и коэффициентов оптического преломления.

Исследования оптических и диэлектрических свойств выбранного нематика представляют большой интерес в связи с тем, что его молекулы близки по структуре к молекулам хорошо известных и подробно изученных ЖК из серии алкилцианобифенилов *n*-CB (n = 5-9) [3–7]. Отличие состоит лишь в том, что в жестком остове молекулы ЗРСН одно бензольное кольцо замещено циклогексановым фрагментом. Кроме того, молекула ЗРСН имеет низкое для ЖК число метиленовых секторов в алкильном "хвосте" (n = 3), такое же как и в ЖК 5-пропил-2 (п-цианфенил)-пиридин [8]. Однако в отличие от случая пиридинсодержащего ЖК постоянный дипольный момент в кристалле ЗРСН связан с наличием группы $-C \equiv N$ и направлен вдоль длинной оси молекул.

Измерение диэлектрической проницаемости проводилось с помощью емкостных и специальных микрополосковых датчиков. Конструкция датчиков, аппаратура и методика измерений описаны в работах [10,11]. Абсолютная точность определения диэлектрических характеристик была не хуже $\delta \varepsilon' \sim 0.05$ и $\delta \varepsilon'' \sim 0.1$. Требуемый угол φ наклона длинных осей молекул по отношению к направлению поляризации высокочастотного поля устанавливался ориентацией постоянного магнитного поля H = 2500 Oe. Измерения диэлектрических спектров проводились при температуре $t = t_c - 5^{\circ}$ С. Для вычисления активационной энтальпии, отвечающей случаям продольной и поперечной накачки образца, соответствующие диэлектрические спектры регистрировались дополнительно при $t = t_c - 10^{\circ}$ С. Статические значения диэлектрической проницаемости измерялись в температурном интервале $30-60^{\circ}$ C на частоте 1 MHz, где дисперсия еще практически не проявляется. Точность стабилизации температуры устанавливалась не хуже $\pm 0.5^{\circ}$ C.

Температурные зависимости оптических показателей преломления для обыкновенного n_e и необыкновен-

ного n_0 лучей проводились на длине волны света $\lambda = 0.589 \,\mu$ m с использованием стандартного рефрактометра ИРФ-454 Б при гомеотропной ориентации директора в измерительной ячейке. Эти данные необходимы для проведения численной аппроксимации диэлектрических спектров.

На рис. 2 представлены результаты измерений температурных зависимостей оптических показателей преломления (темные символы): n_e (1) и n_0 (2), в изотропном состоянии — кривая 5. Здесь же показаны зависимости от температуры действительных компонент диэлектрической проницаемости (светлые символы): продольной ε'_{\parallel} (3) и поперечной ε'_{\perp} (4), измеренных соответственно при параллельной и перпендикулярной ориентации директора молекул ЖК относительно электрического поля накачки; в изотропном состоянии — кривая 6. Скорость охлаждения исследуемого образца в этом эксперименте задавалась ~ 4°C/h. Видно, что как в нематической фазе (кривые 1-4), так и в изотропном состоянии (5, 6)наблюдаются слабые зависимости измеренных констант от температуры. Обращает на себя внимание относительно небольшая величина оптической анизотропии $\Delta n = n_e - n_0 \approx 0.11.$

Частотные зависимости действительной и мнимой компонент диэлектрической проницаемости кристалла ЗРСН измерены в нематической фазе при углах направления директора относительно направления поляризации электрического поля накачки $\varphi = 0, 10, 20, 45, 70, 80$ и 90°С. Для численной аппроксимации диэлектрических спектров $\varepsilon'_{\varphi}(f)$ использовалась сумма трех дебаевских процессов, различающихся временами релаксации τ_1, τ_2 и τ_3 ,

$$\frac{\varepsilon'(f) - n_{\varphi}^2}{(\varepsilon'_{0\varphi} - n_{\varphi}^2)} = \sum_{i=1}^3 \frac{g_i}{1 + 4\pi^2 f^2 \tau_i^2},\tag{1}$$

где $n_{\varphi} = n_e \cos^2 \varphi + n_0 \sin^2 \varphi$, $\varphi'_{0\varphi}$ — значение статической диэлектрической проницаемости при заданном



Рис. 2. Температурные зависимости оптических n_e , n_0 (темные символы) и диэлектрических $\varepsilon_{\parallel 0}$, $\varepsilon_{\perp 0}$ (светлые символы) характеристик жидкого кристалла ЗРСН в области фазового перехода нематик–изотропная жидкость. Пояснения для кривых даны в тексте.





Рис. 3. Частотные зависимости действительной (светлые символы) и мнимой (темные символы) компонент диэлектрической проницаемости при различных углах ориентации директора молекул ЗРСН. Сплошные линии — дебаевские аппроксимации, штриховые линии *1*–3 показывают вклад трех механизмов релаксации соответственно (см. текст).

угле φ , g_i — весовые множители, сумма которых $g_1 + g_2 + g_3 = 1$. Предполагается, что первые два слагаемых в выражении (1) характеризуют процессы вращения (переориентации) молекул вокруг коротких и длинных осей соответственно, а третье описывает набор конформационных движений метиленовых групп в алкильном "хвосте". Очевидно, при таком подходе величина τ_3 является некоторым средним или наиболее вероятным временем релаксации для всех конформационных движений в алкильном "хвосте".

На рис. 3 приведены частотные зависимости нормированных значений $\varepsilon'(f)$ (светлые символы) и абсолютных значений $\varepsilon''(f)$ (темные символы), измеренные для углов $\varphi = 0, 45$ и 90°. Здесь же сплошными линиями показаны их численные аппроксимации, проведенные по формуле (1). Штриховые линии (1–3) показывают индивидуальный вклад в общую дисперсию диэлектрической проницаемости от каждого из трех рассмотренных процессов релаксации. Отметим, что предложенная в данной работе аппроксимация дает достаточно хорошее совпадение расчетной дисперсии диэлектрической проницаемости с экспериментальными данными для всех углов ориентации директора и во всем исследованном диапазоне частот.

Как и следовало ожидать, для угла $\varphi = 0^{\circ}$, когда зависимость $\varepsilon'(f) = \varepsilon'_{\parallel}(f)$, поведение диэлектрического спектра в "низкочастотной" области релаксации в основном определяется процессами вращения молекул вокруг короткой оси $(g_1 = 0.95, \tau_1 = 9 \text{ ns})$. Вычисленная на основании температурной зависимости $\tau_1(t)$ активационная энтальпия составила $\Delta H_1 = 72 \pm 4 \text{ kJ/mol}$, что характерно для процесса переориентации молекул вокруг короткой оси в нематической фазе. Небольшой вклад от конформационных движений алкильного "хвоста" $(g_3 = 0.05, \tau_3 = 0.2 \text{ ns})$ проявляется в "высокочастотной" области дисперсии. Однако при такой ориентации директора вклада в дисперсию $\varepsilon'_{\parallel}(f)$ от вращения молекул вокруг длинной оси не наблюдается $(g_2 = 0)$.

Из рис. З также видно, что для угла $\varphi = 45^{\circ}$ вклад в диэлектрическую дисперсию вносят все три рассмотренных процесса релаксации с весовыми коэффициентами одного порядка ($g_1 = 0.66, g_2 = 0.11, g_3 = 0.23$). При этом вклад от поворотов молекул вокруг длинной оси (время релаксации $\tau_2 = 1.4 \, \text{ns}$) наибольший, а от поворотов молекул вокруг короткой оси — наименьший. Для угла $\varphi = 90^{\circ}$, когда $\varepsilon'(f) = \varepsilon'_{\perp}(f)$, при аппроксимации диэлектрического спектра также необходим учет всех трех процессов релаксации. Но в этом случае вклад механизма переориентации молекул вокруг короткой оси существенно уменьшается ($g_1 = 0.05$). Вклады же двух других механизмов оказываются сопоставимыми $(g_2 = 0.41, g_3 = 0.54)$, но тем не менее превалирует вклад от конформационных движений алкильного "хвоста". Это довольно неожиданный результат, однако он объясняет причины столь сильного отклонения диэлектрических спектров $\varepsilon'_{\perp}(f)$ от дебаевской зависимости в высокочастотной области диэлектрического спектра.

Важно отметить, что, так же как и τ_1 , время поперечной релаксации τ_2 изменяется в зависимости от температуры, но вычисленная на основании функции $\tau_2(t)$ активационная энтальпия оказывается значительно меньше: $\Delta H_2 = 9 \pm 2$ kJ/mol. В нематической фазе ЖК температурной зависимости времени релаксации τ_3 в исследованном температурном интервале нами не обнаружено.

В таблице приведены значения времен релаксации и весомых множителей, а также показателей оптического преломления и статической диэлектрической проницаемости, полученные для некоторых углов ориентации директора относительно направления поляризации поля накачки. Видно, что времена релаксации слабо зависят от угла φ , однако τ_1 достигает своего максимума при $\varphi \approx 70^\circ$, а наибольшее значение τ_2 наблюдается при $\varphi \approx 45^\circ$. Это может свидетельствовать о проявлении Основные характеристики исследуемого жидкого кристалла при различных направлениях поляризации высокочастотного электрического поля относительно директора

$\varphi,^{\circ}$	τ_1 , ns	τ_2 , ns	τ_3 , ns	g_1	<i>g</i> ₂	<i>g</i> 3	п	\mathcal{E}_0
0	9	_	0.20	0.95	0	0.05	1.600	15.69
10	8	_	0.25	0.90	0	0.10	1.597	13.70
20	8	_	0.25	0.90	0	0.10	1.596	12.50
45	11	1.56	0.23	0.66	0.11	0.23	1.545	9.57
70	13	1.40	0.25	0.35	0.30	0.35	1.503	7.55
80	10	1.41	0.24	0.10	0.44	0.46	1.493	6.10
90	8	1.40	0.25	0.05	0.41	0.54	1.490	6.05

некоторых слабых механизмов релаксации, возникающих при определенных углах φ и замедляющих переориентацию молекул вокруг короткой и длинной осей. Время релаксации τ_3 можно считать практически не зависящим от угла φ .

Таким образом, в настоящей работе в широком диапазоне частот измерены диэлектрические проницаемости ЖК ЗРСН при различной ориентации директора молекул относительно направления поляризации электрического поля. При численной аппроксимации диэлектрических спектров использована сумма трех уравнений Дебая с разными временами релаксации. Предложенная аппроксимация $\varepsilon'(f)$ позволяет выявить важные закономерности в изменении соотношений вкладов трех важнейших механизмов релаксации в ЖК (поворотов молекул вокруг короткой и длинной осей, а также внутримолекулярных конформационных движений алкильного "хвоста") в зависимости от угла направления поляризации поля накачки φ относительно директора. Однако такой способ аппроксимации дает хороший результат лишь для молекул с малым числом *n* метиленовых сегментов в "хвосте", когда можно считать, что реальные распределения времен релаксации вблизи τ_1, τ_2 и τ_3 практически не перекрываются. При увеличении *n* > 3 область времен релаксации, связанная с внутримолекулярными движениями, расплывается, поэтому использование тз как параметра эффективного времени релаксации теряет смысл. В этом случае хорошую аппроксимацию диэлектрических спектров можно получить, применяя в уравнении Дебая несимметричную функцию непрерывного распределения времен релаксации в определенном интервале.

Исследования показали, что внутримолекулярные движения в ЖК оказывают некоторое влияние на дисперсию диэлектрической проницаемости $\varepsilon'_{\parallel}(f)$, хотя в основном она определяется поворотами молекул вокруг короткой оси. При этом полностью отсутствует вклад в дисперсию, связанный с движениями молекул вокруг длинной оси. Установлено также, что в дисперсию $\varepsilon'_{\perp}(f)$ вносят вклады все три рассмотренных механизма релаксации, причем наибольшим является относительный вклад внутримолекулярных движений.

Список литературы

- Л.М. Блинов. Электро- и магнитооптика жидких кристаллов. Наука, М. (1978). 384 с.
- [2] А.А. Потапов, М.С. Мецик. Диэлектрическая поляризация. Изд-во Иркут. ун-та, Иркутск (1986). 263 с.
- [3] D.A. Dunmur, M.R. Manterfield, W.H. Miller, J.K. Dunleavy. Mol. Cryst. Liq. Cryst. 45, 127 (1978).
- [4] P.G. Gummins, D.A. Dunmur, D.A. Laidler. Mol. Cryst. Liq. Cryst. 30, 109 (1975).
- [5] B.R. Ratna, R. Shashidar. Mol. Cryst. Liq. Cryst. 42, 185 (1977).
- [6] J.M. Wacrenier, C. Druon, D. Lippens. Mol. Phys. 43, 97 (1981).
- [7] Б.А. Беляев, Н.А. Дрокин, В.Ф. Шабанов, В.Н. Шепов. ФТТ 45, 3, 567 (2003).
- [8] Б.А. Беляев, Н.А. Дрокин, В.Ф. Шабанов. ФТТ 45, 4, 756 (2003).
- [9] Е.М. Аверьянов. Эффекты локального поля в оптике жидких кристаллов. Наука, Новосибирск (1999). 552 с.
- [10] Б.А. Беляев, Н.А. Дрокин, В.Н. Шепов. ЖТФ 65, 2, 189 (1995).
- [11] Б.А. Беляев, Н.А. Дрокин, В.Ф. Шабанов, В.Н. Шепов. ЖТФ 72, 4, 99 (2002).